

## عنوان مقاله:

بهبود مدارات فشرده ساز در ضرب کننده ها با استفاده از ترانزیستورهای فین فت

## محل انتشار:

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

## نویسندگان:

نرگس فیضیان - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه لرستان

عباس رضانی - استاد برق الکترونیک دانشگاه لرستان

## خلاصه مقاله:

در این مقاله کارایی مدار کمپرسور یک ساختار افزاره چند گیتی ( FinFET ) ( با ساختار تک گیتی سنتی ) ( MOSFET ) مقایسه میشود. ابتدا به مدل سازی و شبیه سازی تمام جمع کننده 82 ترانزیستوری CMOS و فین فت با تکنولوژی 28 نانو متر با نرم افزار HSpice پرداختیم؛ سپس اقدام به شبیه سازی فشرده ساز 2:8 با استفاده از طرح پیشنهادیمان کردیم و برای مقایسه بهتر فشرده ساز 2:8 را با استفاده از ترانزیستورهای ماسفت نیز پیاده سازی نمودیم و مشاهده شد که فشرده ساز 2:8 پیشنهادی مبتنی بر فین فت از عملکرد بالایی نسبت به نمونه CMOS برخوردار بوده و در عین حال بطور چشمگیری تعداد ترانزیستورها کاهش یافته است.

## کلمات کلیدی:

کمپرسور، فین فت، ماسفت، EDP ، PDP

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/404811>

